



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1116

对应国外型号
KSB1116

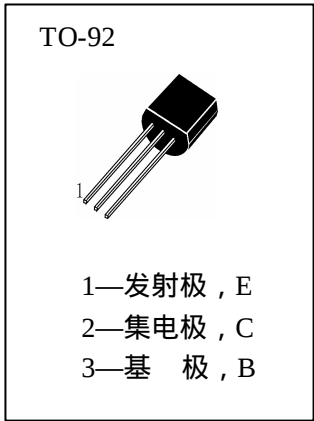
主要用途

音频功率放大，中速开关应用。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	750mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-60V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-50V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-6V
I_C ——集电极电流.....	-1A
I_{CP} ——集电极电流(脉冲).....	-2A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-60			V	$I_C=-10\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-50			V	$I_C=-1mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-6			V	$I_E=-10\mu A, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	nA	$V_{CB}=-60V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	nA	$V_{EB}=-5V, I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	135		600		$V_{CE}=-2V, I_C=-100mA$
$H_{FE}(2)$		81				$V_{CE}=-2V, I_C=-1A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		-0.2	-0.3	V	$I_C=-1A, I_B=-50mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压		-0.9	-1.2	V	$I_C=-1A, I_B=-50mA$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压	-600	-650	-700	mV	$V_{CE}=-2V, I_C=-50mA$
f_T	特征频率	70	120		MHz	$V_{CE}=-2V, I_C=-100mA$
C_{ob}	共基极输出电容		25		pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$

HFE(1) 分档及其标志

Y	G	L
135—270	200—400	300—600



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1116

对应国外型号

KSB1116

特性曲线

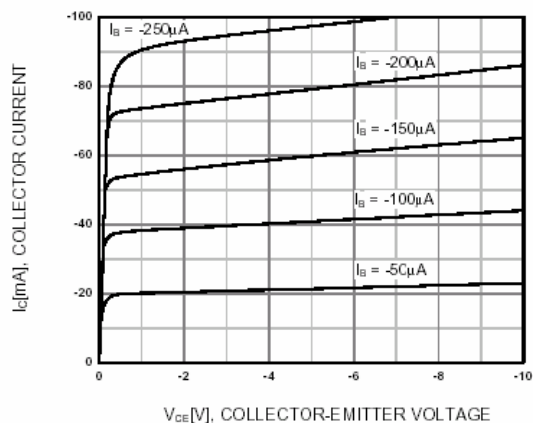


Figure 1. Static Characteristic

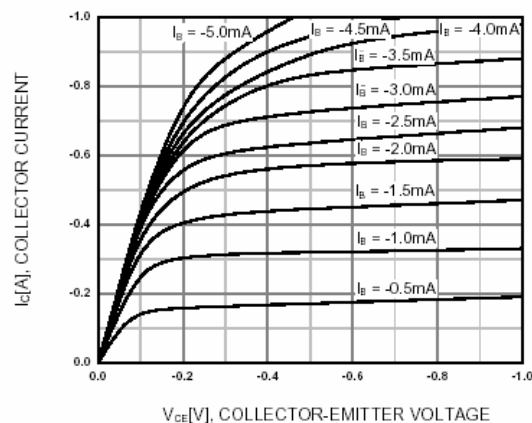


Figure 2. Static Characteristic

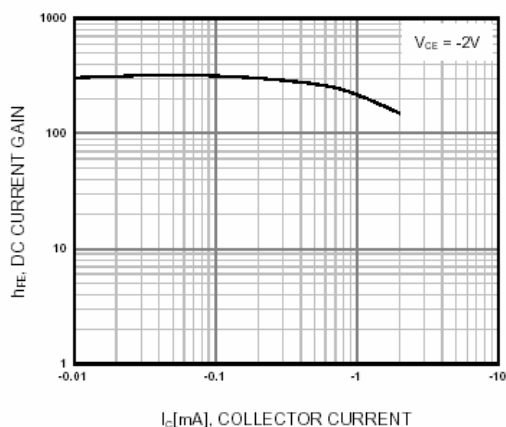


Figure 3. DC current Gain

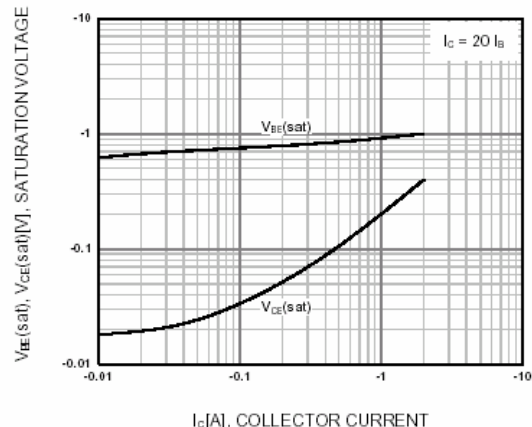


Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage

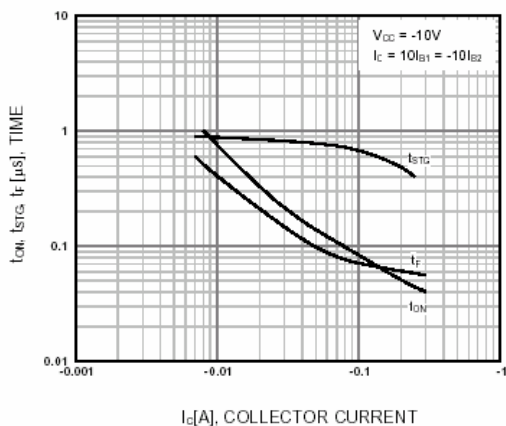


Figure 5. Switching Time

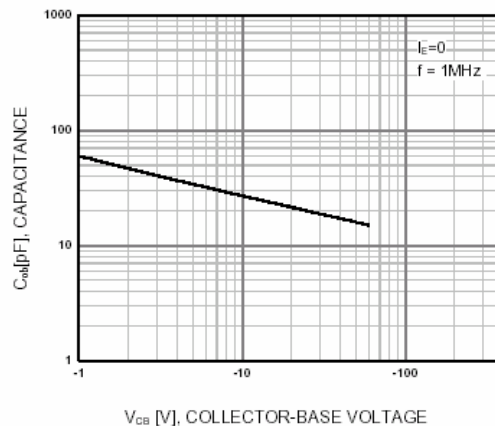


Figure 6. Collector Output Capacitance



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1116

对应国外型号

KSB1116

特性曲线

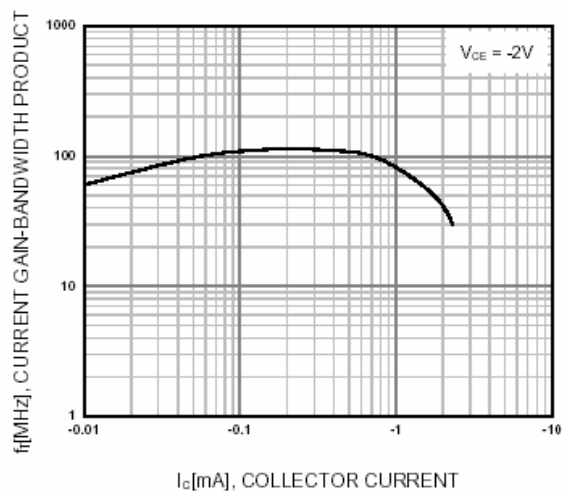


Figure 7. Current Gain Bandwidth Product

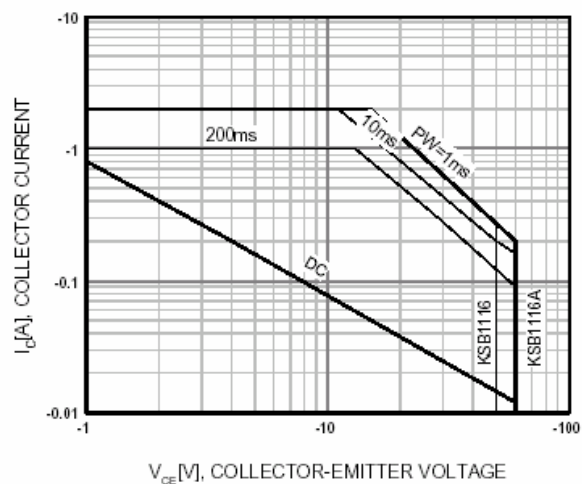


Figure 8. Safe Operating Area

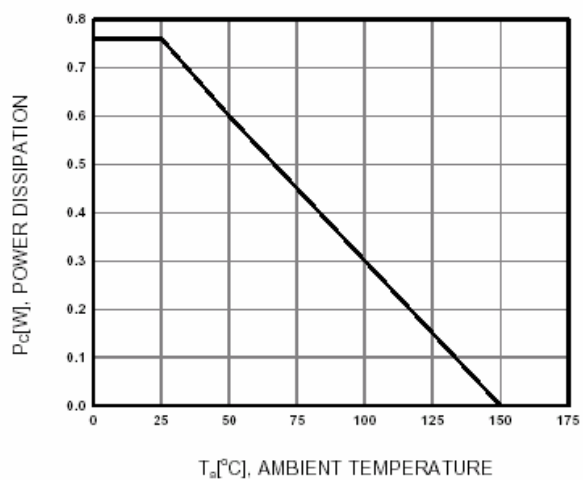


Figure 9. Power Derating